PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-281856

(43)Date of publication of application: 07.12.1987

(51)Int.CI.

C07D201/04 B01J 29/28 B01J 31/12

(21)Application number : 62-017748

(71)Applicant: SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

27.01.1987

(72)Inventor: SATO HIROSHI

HIROSE KENICHI **ISHII NORIO**

TOSHIMA HIDETO KITAMURA MASARU

(30)Priority

Priority number: 61 43441

Priority date: 07.03.1986

Priority country: JP

(54) PRODUCTION OF EPSILON-CAPROLACTAM

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce the objective compound over a long period in high productivity, by contacting cyclohexanone oxime in vapor phase with a specific crystalline zeolite catalyst surface-treated with a specific organometallic compound.

CONSTITUTION: ε-Caprolactam useful as a raw material for nylon, etc., is produced by contacting cyclohexanone oxime in vapor phase with a specific crystalline zeolite catalyst having a control index of 1W12. In the above process, the catalyst is treated its surface with an organometallic compound of formula R4-nMXn (R is 1W6C alkyl or phenyl; M is Si or Ge; X is Cl or 1W6C alkoxy; n is 1 or 2) and preferably has an outer surface area of the pore of ≥5m2/g, especially an aluminosilicate zeolite or metallosilicate zeolite having an Si/Al or Si/metal atomic ratio of ≥500. The conversion of the raw material and the selectivity to the objective compound can be improved and the catalytic life can be prolonged by the suppressed carbon deposition on the catalyst.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-281856

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和62年(1987)12月7日

C 07 D 201/04 29/28 B 01 J

7043-4C -6750—4G

-7158-4G

未請求 発明の数 1 (全14頁) 審査請求

69発明の名称

εーカプロラクタムの製造法

20特 願 昭62-17748

洋

光凞

②出 願 昭62(1987)1月27日

優先権主張

發昭61(1986)3月7日39日本(JP)30特願 昭61-43441

明 四発 者 ⑫発 明 者 明 者 79発

佐 藤 廣 瀬 石

高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社内 高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社内 高槻市塚原2丁目10番1号

住友化学工業株式会社内

明 者 勿発

蜸 # 生 島 秀 人

高槻市塚原2丁目10番1号

住友化学工業株式会社内

眀 者 勿発

北 村

戸

高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社内 勝 大阪市東区北浜5丁目15番地

人 住友化学工業株式会社 ⑦出 顖 弁理士 諸石 個代 理

外1名

艍

発明の名称

-----ぇ----カープ-ロ--ラ-ク-ターム-の 製-造・法------

2. 特許請求の範囲

シクロヘキサノンオキシムを気相下に制御 指数1~12の結晶性セオライト系触媒と接 触せしめてεーカプロラクタムを製造するに 当り、触媒として一般式(I)

 $R_4 = nMXn$

(1)

(式中、 R は同一もしくは異なる炭素数 1 ~6のアルキル基又はフェニル基を示し、 MはSi 又はGe、XはCl 又は炭素数1~6 のアルコキシ基を示し、nは1又は2を示

で表わされる有機金属化合物で表面処理した 結晶性ゼオライト系触媒を使用することを特 徴とするεーカプロラクタムの製造法。

(2) 結晶性ゼオライト系触媒がアルミノシリケ ート・ゼオライトであり、その Si/Al 原子比 が500以上である特許額求の範囲第1項記 載のヒーカプロラクタムの製造法。

- (8) 結晶性ゼオライト茶触媒がメタロシリケー --ト---ゼ-オ-ラ-イ-ト-であり、--そ-の-Si-/-メ-タール・原子 比が、500以上である特許請求の範囲第1 項記載のεーカプロラクタムの製造法。
- (4) 結晶性ゼオライ系触媒の細孔外表面積が 5 元/8 以上である特許請求の範囲第1~3項の ε ーカプロラクタムの製造法。
- 8. 発明の詳細な説明

く産業上の利用分野>

本発明はεーカプロラクタムの製法に関し、 詳しくはシクロヘキサノンオキシムからヒーカ プロラクタムを製造するにあたり、触媒として 特定の薬剤で表面処理を行った結晶性ゼオライ ト系触媒を用いることを特徴とするモーカプロ ラクタムの製法に関するものである。

く従来の技術>

εーカプロラクタムはナイロン等の原料とし て用いられている重要な基幹化学原料であり、 その製造法としては従来より、触媒として硫酸 を用い、液相下にシクロヘキサノンオキシムを 転位させる方法が採用されている。

また触媒として固体皺を用い、気相下に転位させる方法も態々提案されている。例えばホウ酸系触媒(特朗昭 5 8-3 7 6 8 6 号、同4 6-1 2 1 2 5 号公報)、シリカ・アルミナ系触媒(英国特許第 8 8 1,9 2 6 号)、複合金齃酸化触媒(日本化学会誌(1977)Na 1 77)、ゼオライト系触媒

(Journal of Catalysis <u>6</u>, 247(1966)、特開 昭 57-189062 **号**公報)等を用いる方法が知ら れている。

<発明が解決しようとする問題点>

前記の硫酸を用いる方法では多数の発煙硫酸を必要とするのみならず硫安を大量に副生するという問題、更には発煙硫酸による装置の腐食等の問題がある。

一方、 このような問題点を解決する方法として、 前記のような種々の固体酸を用いる方法が 提案されているが、 いずれの方法も目的物であ

寿命等を同時御足するものではなく、また生産 性の面でも充分ではなく、更に一層の改良が望 まれていた。

<問題点を解決するための手段>

すなわち本発明はシクロヘキサノンオキシムを気相下に制御指数 1 ~ 1 2 の結晶性ゼオライト系触媒と接触せしめて c - カプロラクタムを製造するに当り、触媒として一般式(1)

 $R_{4-n} M X_{n}$ (1)

(式中、Rは同一もしくは異なる炭素数1~

る c ーカブロラクタムの反応選択率、 触媒系命 あるいは 触媒当りの生酉性などの点で問題を残 している。

例えば削記特開昭 57-139062 号公報には触媒として40~60の Si/A&原子比を有する2SM-5 等の結晶性ゼオライトを用いる具体例が示され、シクロヘキサノンオキシムの転化率は定量的と記載されてはいるものの、その場合の重整空間速度(以下 WhISV と略称する)は約 2.5 hr⁻¹と著しく低く、また触媒労命も15~20時間と短い結果が示されている。

本発明者らも該公報に記載されているようなSi/Al 原子比の ZSM 系ゼオライトを触媒として実際に検討したが、触媒の寿命のみならず。一カブロラクタムへの選択率も充分な値を示さず殊に実用的な WHSV、例えば約 1 0 nr⁻¹ 以上の条件下では触媒寿命が極めて短く、しかも選択率が著しく低いことを確認した。

このように固体破触媒を用いた公知の方法も オキシムの転化率、ラクタムへの選択率、触媒

6のアルキル基又はフェニル基を示し、MはSi又はGe、XはCl又は炭素数1~6のアルコキシ基を示し、nは1又は2を示す。)で表わされる有機金属化合物で表面処理した結晶性ゼオライト系触媒を使用することを特効と

で送わされる有機金属化合物で表面処理した結晶性ゼオライト系触媒を使用することを特徴とする工業的に極めて優れた。一カプロラクタムの製造法を提供するものである。

本発明においては、触媒として制御指数1~12の結晶性ゼオライト系触媒を上記有機金属化合物類で表面処理した触媒が用いられるが、制御指数1~12の結晶性ゼオライトとしては、アルミノシリを一ト・ゼオライト及び、アルミニウム以外の金属原子で骨格置換されたメタロシリケート・ゼオライトがある。前者に属するものとしては、モービル・オイル社によって開発された「2SM系ゼオライト」と絵称されるものや、U.C.C社によって開発された「シリカライト」と総称されるものが代表的なものが代表的なものが、「Nu 系ゼオライト」、「Eu 系ゼオライト」(1.C.I.社、Catalysis Reviws—Seience &

Engineering 27,461(1985))、「2BM 茶ゼオライ ト」(BASF社、西独特許 2,830,787号(1980)、 8,006,471号(1981)、「TP2系ゼオライト」 (帝人油化社、特朗昭 57-95281、同 57-149819号公報)と総称されるものも含まれる。

メタロシリケート・ゼオライトに属するもの としては、上記各アルミノシリケート・ゼオラ イトに於て、アルミニウム原子が他の金属原子 で骨格置換したものが載げられるが、具体的に はガリウム・シリケート、鉄・シリケート、コ バルト・シリケート、 ポロン・シリケート、チ タン・シリケート、 ジルコニウム・シリケート、 ニオブ・シリケート、ピスマス・シリケート、 亜鉛シリケート、クロム・シリケート、ベリリ ウム・シリケート、ランタン・シリケート、ハ フニウム・シリケート、パナジウム・シリケー ト、ニッケル・シリケート、アンチモン・シリ ケート等の結晶性メタロシリケート・ゼオライ トが載げられる。

ててで、制御指数とは、ゼオライト結晶の細

(特公昭51-149900号公報) 25M-28 9.1 2SM-85 (特開昭53-144500号公報)

ZSM-88

2 SM-48 8.4 (特別2056-188228 号公報)

(米国特許第4.061.724号) シリカライト

これらの特性X級パターンおよびその製法に ついては、それぞれの出典に記載されている。

また上記各結晶性アルミノ・シリケート・ゼ オライトのアルミニウムを他の金属で監換した 各々の結晶構造に対応する結晶性メタロシリケ ート・ゼオライトも、制御指数1~12の結晶 性ゼオライトの具体例として載げられる。

これ等の中でも、 2SM-5及びシリカライト あるいはそれ等に対応する結晶構造を有するメ タロシリケート・ゼオライトが特に好ましい。

また制御指数1~12を有する結晶性ゼオラ ィトの中でも Si/Al 原子比又は、 Si/メタル原 子比が大きい方が有機企具化合物類による表面 処理効果が高く、 Si/Al 原子比又は Si/メタル 原子比は好ましくは200以上、より好ましく

孔構造がn-ヘキサンより大きな断面積の分子 の接近を制御する程度を示すものであり、下式 によって定義される。具体的測定方法は特開昭 56-188228 母公報に示されているが、その概 要は、有効分子径の異なるn-ヘキサンと8-メチルペンタンの混合物を特定の条件下、ゼオ ライト触媒に接触せしめてクラッキング反応さ せ、その反応性比から制御指数を算出するもの である。測定条件によって若干異なる値を示す こともあり、通常いくつかの条件下で測定し、 その平均値が採用される。

log to (残存するn-ヘキサン分) 制御指数= logio (残存する3ーメチルペンタン分)

制御指数が1~12の結晶性ゼオライトの具 体例としては例えば下記の結晶性アルミノ・シ リケート・ゼオライトが挙げられる。・

制御指数

(特公昭46-10064号公報) 2 SM-5 8.8 (特公昭53-23280号公報) ZSM-11 8.7 2 SM-12 (特公昭52-16079号公報)

は500以上である。

また細孔外表面積も大きい方が表面処理効果 孔外酸量も少ない方が表面処理効果は高い傾向 を示す。

> ことで Si/Al 又は Si/メタル原子比はゼオラ イト結晶骨格中の Si および Al 又はメタルの正 雖な元素分析、例えばX級分析で高い結晶化度 を確認した後、原子吸光分析などから求めると とができる。またMAS-NMR スペクトルの²⁹Si シグナルからもゼオライト骨格の Si/A& 比又は Si/メタル比を算出することができる。

一方細孔外表面敬は、結晶性ゼオライトの結 晶内細孔を有機または無機の分子で充填し、外 部表面への窒素またはクリプトンの吸着量から BET法により細孔外表面積を算出すると云っ た面常の細孔充填法が採用される。この際、細 孔を充填する分子としては、ブタン、ヘキサン、 ペンゼン等の有概分子や水を使う方法(日本触 蝶学会 第7回(1984年)及び解8回(1985

年)参照触媒討論会資料)あるいはゼオライト の水熱合成時に結晶化調整剤として使用した有 機プミンやテトラアルキルアンモニウムカチオ ンを利用する方法がある。後者の方法について 補足説明すると、制御指数が1~12の結晶性 ゼオライトで、しかも Si/Al 又は Si/メダル原 子比が大きい高シリカゼオライトを水熱合成で 得るためには、通常有機アミンやテトラアルキ ルアンモニウムカチオンを結晶化調整剤に使う が、水熱合成直後は、これ等の結晶化調整剤が 生成ゼオライトの細孔を充填した形で存在する。 従って水熱合成直後のゼオライトを120℃以 下の温度で十分に乾燥しただけの状態でBET 表面積を測定すれば、その値は細孔外表面積に 相当する(日本触媒学会、第10回(1986 年)参照触媒討論会資料)。

制御指数 1 ~ 1 2 の結晶性ゼオライト系触媒は公知の方法によって製造されるが、 Si/Aℓ原子比の大きいものは、例えば特開昭 59-164617 号公報、米国特許第 4061724号、あるいは触媒

本発明は触媒として、上記のような結晶性ゼ オライトを、更に前配一般式(1)で示される特定 一の有機金属化合物で表面処理したものを用いる…… が、それらのうち、有機ケイ素化合物としては、 例えば、クロロトリメチルシラン、クロロトリ エチルシラン、クロロトリーnープロピルシラ ン、クロロトリーn-ブチルシラン、クロロト リーヒープチルシラン、クロロトリーローペン チルシラン、クロロトリーiーアミルシラン、 クロロトリーローベキシルシラン、クロロフェ ニルジメチルシラン、クロロジフェニルメチル シランなどのモノクロロシラン類、あるいはジ クロロジメチルシラン、ジクロロジエチルシラ ン、ジクロロジーn-プロピルシラン、ジクロ ロジーローペンチルシラン、ジクロロジーi-アミルシラン、ジクロロジーn-ヘキシルシラ ン、ジクロロフェニルメチルシランなどのジク ロロシラン類、あるいはメトキシトリメチルシ ラン、メトキシトリエチルシラン、メトキシト リーn-プロピルシラン、メトキシトリーn-

28(3) 282(1981) 等に記載の方法によって製造することができる。また、 Si/メタル原子比の大きい結晶性メタロシリケート・ゼオライトは上配方法で、Al 原料に代えて、他の金属化合物を使用する事によって得る事が出来る。また細孔外表面徴の大きいものは水熱合成時の温度を低くするとか、機拌を激しくしたりすることにより得ることができる。

また水熱合成して得られるゼオライトは通常、結晶化調製剤としての有機アミンカチオンのの大力を含むないので、空気中焼成して有機アミンや希塩酸水でのが大力を強力して、H⁺型に次換後再焼成して、H⁺型に次換や希塩酸水のが、塩化アンモニア水や海塩酸水のが、塩化アンモニア水や海塩酸水のが、カリに、Ca²⁺、Mg²⁺、Sr²⁺、Ba²⁺等のランタノイド類金属イオンを含類なオンを含類でする。できる。

ブチルシラン、メトキシトリーnーペンチルシ ラン、メトキシトリーローヘキシルシラン、メ トキシフェニルジメチルシラン、エトキシトリ メチルシラン、エトキシトリエチルシラン、エ トキシトリーロープロピルシラン、エトキシト リーロープチルシラン、エトキシトリーローへ キシルシラン、エトキシフェニルジメチルシラ ン及びこれらのメトキシ又はエトキシ基が他の Ca ~ Ca アルコキシ基である様なモノアルコキ シシラン類、あるいはジメトキシジメチルシラ ン、ジメトキシジエチルシラン、ジメトキシジ ーnープロピルシラン、ジメトキシジーn-ブ チルシラン、ジメトキシジーn-ヘキシルシラ ン、ジメトキシフェニルメチルシラン及びこれ らのメトキシ遊が他の Ce ~ Ce アルコキシ基で ある様なジアルコキシシラン類などが載げられ

一般式(1)で示される有機ゲルマニウム化合物 としては、上配各有機ケイ素化合物の Si を Ge で置き換えたものに対応する有機ゲルマニウム 化合物が載げられる。

これら有機金属化合物類による表面処理は結晶性 ゼオライトと有機金属化合物類を気相あるいは液相で接触混合することにより行うことができるが、通常は気相で接触させ表面処理をする方法が選ばれる。

ルエン溶液として希釈供給するのが好ましい。 ベンゼンもしくはトルエンで希釈して供給、 反応させる場合、反応キャリャーガスは使わな くてもよいが、 N2, CO2 等の不活性ガスをギャ リャーガスとして反応させてもよい。

キャリャーガスを使うとラクタムへの選択率を向上させる傾向が見られ、特に CO: キャリャーにその効果が著るしい。

接触転位反応温度は通常 200 $C\sim500$ C、特に好ましくは 300 $C\sim450$ Cの範囲である。 原料フィード速度は通常 WHSV= $0.1\sim100$ hr⁻¹、好ましくは $1\sim50$ hr⁻¹より好ましくは $5\sim40$ hr⁻¹である。

反応混合物からの・一カプロラクタムの単離は、例えば反応混合ガスを冷却して機縮せしめ、 次で蒸留あるいは再結晶などにより未反応原料 等と分離される。

く発明の効果>

かくしてモーカブロラクタムが製造されるが、 本発明によればシクロヘキサノンオキシムの転 また固定床式反応管に代えて回転式反応管を用いて、結晶性ゼオライトを挽拌混合下に安面処理することもでき、そうすることによって安面処理の均一性を向上させることもできる。

表面処理操作においては結晶性ゼオライト表面のシラノール基と有機金属化合物類とが反応しHClないし、アルコールが脱離してくると推定されるが、装面処理後は、これ等の脱離HClやアルコールや未反応有機金属化合物類が結晶性ゼオライト中に残存しないように希釈ガスまたは溶剤で十分洗浄、除去を行う。

本発明方法は上記のような有機金属化合物類で表面処理された結晶性 ゼオライト系触媒を用いるものであるが、シクロヘキサノンオキシムと接触させるにあたっては、通常、固定床または流動床を用いた気相接触方式が採用される。

原料のシクロヘキサノンオキシムは原料気化器を通して気化させ、気体状態で触媒床と接触 反応せしめるが、その際、シクロヘキサノンオキシム単独で供給しても良いが、ベンゼンやト

化率が向上するのみならず ε ーカプロラクタムへの選択率が著しく向上し、しかも触媒上の炭素折出も極めて少く触媒の寿命も著しく伸び、長期間にわたり高い成績で ε ーカプロラクタムが得られる。

本発明によれば、より高い WHSV をも採用でき、触媒当りの生産性を著しく向上し得る等の利点ももたらす。

<実施例>

以下、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。

触媒調製例 1

(1-1) H·ZSM-5の合成

1.5 & のステンレス製オートクレーブに、 テトラエチルオルソシリケート (Si(OEt)₄, A&<10 ppm) 100 %、10%水酸化テトラー n ープロピルアンモニウム水溶液 224 %、エタノール 60% を仕込みよく攪拌した。この混合液に、予じめ調整した硫酸アルミニウ ム水溶液 4 8 9 [Al2 (SO4) * 16 H2 O 98 元 水48 9]を加え、8 0 分間激しく攪拌した。尚、混合溶液のpHは13.0であった。オートクレーブのムたを締めつけた後、油浴に及し内温を105℃に保った。同時に400下.p.m以上の回転で攪拌を行ないながら120時間の水熱合成を行なった。オートクレーブの時間の水熱合成を行なった。オートクレー、水熱合成と行なった。カートクレー、水熱合成と行なった。焼いる液のpHは11.8であった。続いる液のpHが7付近になるまで蒸留水で連続的に洗浄した。得られた生成物を120℃で16時間を増た。の段階の結晶を窒素ガス吸着法によりBET表面積を測定したところ、細孔外表徴として10.8 ㎡/9の値を得た。

この乾燥された結晶を、更に 500~580 ℃ で 4 時間、空気気流下で焼成し、 2 7 9 の粉末状白色結晶を得た。 このものの粉末 X 線回折の結果、 2 SM-5 と同定された。また、原子吸光分析法による元素分析の結果、 Si/Ae

の速度でフィードし、反応管入口で N2 ガス(1ℓ√hr) で希釈同伴フィードした。触媒床の温度は 8 5 0 ℃に保持したまま 4 時間表面処理反応を行なった。その後 TMUS のフィードを停止し、N2 ガスを 1 5 分間流し、触媒を洗浄した。この表面処理された H-2SM-5 の表面酸強度は、指示薬法で測定して pKa=-3.0 であった。

また 3 5 0 ℃での 4 - メチルキノリン (4 M Q と略す) 吸着量から測った細孔外酸量は 1.8 4 μeq√9 であった。

実 施 例 1 (固定床気相反応による触媒活性テスト)

長さ82 mm、内径1 mmの石英ガラス製反応管中に、触媒調製例1-2で調製した24~48メッシュ粒径のTMCS処理H-2SM-5 触媒0.69(1.02 ml)を充填し、N2気流下350で1時間予熱処理した。次いで8.0wt%シクロヘキサノンオキシム/ベンゼン溶液を、WHSV(重量空間速度)=11.7 hr⁻¹の速度で、気化器を通してフィードしかつ、

原子比= 1,600であった。

ての結晶 1 0 4 に 5 % - NH C ℓ 水溶液 100 4 を加え、 5 0 ~ 6 0 C で 1 時間イオン交換 処理を行ない、続いて 5 別した。 C のイオン 交換処理を計 4 回行なった後、結晶を C ℓ が 検出されなくなるまで 蒸留水で洗浄した。 続いて 1 2 0 C、 1 6 時間乾燥した。 得られた NH 4 型の結晶を、 2 4 ~ 4 8 mesh に造粒した後 5 0 0 C 4 時間、焼成し、 H型 ZSM-5 とした。尚、 C の H · ZSM-5 の 安面酸強度は指示薬 法で測定して pKa = -8 であった。又、 8 5 0 C での 4 - メチルキノリン(4 M Q と略す) 吸着量は 3.9 2 μeq √ ℓ であった。

(1-2)クロロトリメチルシランによる表面処理

長さ32 cm、内径1 cmの石英ガラス製反応 管中に触媒調製例1-1で調製した24~48 メッシュ粒径のH-ZSM-5触媒を1.0 9 充填し、 N2 気流下350 Cで1時間予熱処理した。 次いでマイクロフィーダーにてクロロトリメ チルシラン(以後 TMCS と略す)を0.6 ml/hr

CO2 ガスを 0.6 l/hrの速度でフィードし反応 させた。オキシム/CO2/ペンゼン= 1/5.6/ 18.8 のモル比であり触媒床の温度(反応温 度)は350 Cであった。

反応生成物は水冷下トラップして指集し、 ガスクロマトグラフィー(カラム: 20% silicone SE-80/chromosorb AW-DMCS(60/80 M) 2m:glasscolumn、内部模準: ブソイドキュメン)にて分析した。

得られた結果を設一1に示す。

安一 1

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	εーカプロラクタム 収 率 (%)	εーカプロラクタム 選択率 (%)
1.8	100	9 1.5	9 1.5
2. 8	100	9 8.2	9 8.2
3.3	100	9 5.0	9 5.0
4.3	100	9 4.5	9 4. 5
5.8	100	9 4.5	9 4. 5
6.3	100	9 4.5	9 4. 5
7. 8	100	9 4.7	9 4.7
9. 6	100	9 5.0	9 5.0
1 1.5	100	9 5.1	9 5.1
1 8.5	100	9 5.0	9 5.0
1 5.5	100	9 5.2	9 5.2
1 8.0	100	9 4.7	9 4.7
2 0.0	9 9. 9	9 4.9	9 5.0
2 2.0	9 9.8	9 4.6	9 4.8
2 4.0	9 9. 8	9 4.8	9 5.0
2 5.0	9 9. 7	9 4.6	9 4. 9
2 7.0	9 9. 3	9 4. 3	9 5.0
2 9.0	9 8.8	9 8.6	9 4.7
3 1.0	9 8.2	9 8.8	9 5.0

参考例 1

触媒調製例1-1で調製したH-ZSM-5を触

蝶に用いる他は、実施例 1 に準じてシクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。 得られた結果を数一 2 に示す。

※ - 2

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率 (%)	εーカプロラクタム 仅 率 (%)	ェーカプロラクタム 選択 率(%)
1.3	100	7 8.4	7 8.4
2.3	100	7 6.7	7 6.7
8.8	100	7 9.7	7 9.7
4.3	100	8 1.0	8 1.0
5.3	100	8 8.9	8 3.9
6.8	100	8 4.2	8 4.2
8.0	100	8 6.6	8 6. 6
1 0.0	100	8 7. 2	8 7. 2
1 2.0	100	8 6.1	8 6.1
1 4.0	100	8 8.8	8 8.8
1 5.0	100	9 0.5	9 0. 5
1 7.0	100	9 1.0	9 1.0
1 9.0	9 9.5	8 9.2	8 9.6
2 0.0	9 9.3	9 0.1	9 0.7
2 5.0	9 7. 3	9 2.4	8 9.8
2 7.0	9 5.8	8 5.6	8 9.4

触媒調製例 2

(2 - 1) H·ZSM-5 の合成

触媒調製例1-1において硫酸アルミニウム水溶液を用いない以外は触媒調製例1と同様に水熱合成後処理を行った。

得られた生成物を1200℃で16時間乾燥した。この段階の結晶を窒素ガス吸着法により、BET表面積を測定したところ、細孔外表面積として、11.7m/9の値を得た。

この乾燥された結晶を更に 500~580 Cで 4 時間、空気気流下で焼成し、 2 5 g の粉末状 白色結晶を得た。このものの粉末 X 線回折の 結果、 2SM-5 と同定された。また、原子吸光 分析法による元素分析の結果、 Si/Al 原子比 2 7,0 0 0 0 であった。

その後は、触媒調製例 1 - 1 に準じ、NH4Cll イオン交換、焼成を経て H-2 SM-5 結晶を得た。 この H・2SM-5の 3 5 0 ででの 4 M Q 吸着量は殆んど等であった。 装面酸強度については、pKa=-3.0 の指示薬(ジシンナマルアセト

ン)でわずかに薄く着色する程度であった。 (2-2) TMCS による表面処理

触媒関製例 2 - 1 で得た H・Z SM-5を用い、 触媒関製例 1 - 2 に平じて、TMCS による表 面処理を行なった。処理された H・Z SM-5 の 表面酸強度は、指示薬法で測定して pKa=+3.8 であった。また 8 5 0 ℃での 4 M Q 吸着量か ら測った細孔外酸盤は殆んど客であった。

実施例2

触媒調製例 2 - 2 で得た TMCS 処理H·ZSM - 5 を触媒に用いる他は災陥例 1 に準じて、シクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を送 - 3 に示す。

表 - 8

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオーキシム 転化率(%)	εーカプロラクタム 収(%)	ェーカプロラクタム 選 択 平 (%)	
1	1 0 0	9 4. 6	9 4. 6	
2	100	9 4. 5	9 4. 5	
8 .	100	9 5.0	9 5.0	
4	100	9 4.9	9 4. 9	
5	100	9 4.8	9 4.8	
7	100	9 5.5	9 5.5	
9	100	9 6.8	9 6.3	
1 2	100	9 6.0	9 6.0	
1 4	100	9 5.0	9 5.0	
1 6	100	9 5.1	9 5.1	
1.8	100	9 4.8	9 4.8	
2 0	100	9-4.9	9 4. 9	
2 2	100	9 4.8	9 4.8	
2 4	9 9.7	9 4.7	9 5.0	
2 6	9 9.7	9 · 8 · 7	9 4.0	
2 8	9 9.4	9 4.8	9 4.9	
3 0	9 9. 2	9 8.9	9 4.7	
8 2	9 9. 2	9 4.8	9 5.6	
8 4	9 8.9	9 8.9	9 5.0	
8 5	9 8.6	9 8.8	9 5.1	

実 胞 例 8 (高 い WHS V 条 件 で の テ ス ト)

長さ82 cm、内径1 cmの石英ガラス製反応管中に、触媒調製例2 - 2 で調製した24~48メッシュ粒径のTMCS 処理 H・2SM-5 0.8 f(0.5 mt)を充填し、8 5 0 ℃で N2 気流下、1 hr. 予熱処理した。次いで 8 wt% シクロヘキサノンオキシム/ベンゼン溶液を WHSV = 88.5 hr⁻¹の速度で気化器を通して供給し、反応させた。触媒床の温度は8 5 0 ℃であった。反応生成物は水冷下トラップして捕集し、ガスクロマトグラフィにで分析した。得られた結果を表ー4に示した。

表 - 4

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率 (%)	eーカプロラクタム 収 邶 (%)	モーカプロラクタム 選 択 平 (%)
1.3	9 9.8	8 8.8	8 8.9
2. 3	9 8.9	9 0.4	9 1.4
3.3	9 8.4	8 9. 7	9 1.2
4. 9	9 7.7	8 9. 6	9 1.8
5.8	9 7. 1	8 7. 9	9 0.5
6.8	9 6.3	8 7. 8	9 1. 2
7. 8	9 5.5	8 8.9	9 8.1

を得た。 このものの分析値は以下のとおりであった。 Si/Al 原子比 = 26,400、細孔外表面 費 = 8.9 元/9、細孔外酸量 = 2.1 8 μeq/9、 表面酸強度は pKa = -8.0

(a - 2) TMCS による表面処理

触媒調製例 3 - 1 で得た H-ZSM-5 を用い触媒調製例 1 - 2 に準じて、TMCS による表面処理を行なった。処理された H-ZSM-5 の表面酸強度は pKa=+8.3 であった。また 850 ででの 4 M Q 吸着進から測った細孔外酸盤は 殆んど客であった。

突施例4(高い WHSV 条件でのテスト)

触媒調製例 8 - 2 で役た表面処理 H-ZSM-5 を触媒に用いる他は実施例 8 に即じてシクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を表 - 6 に示す。

参考例 2

触媒調製例2-1で得た H·ZSM-5を触媒に用いる他は実施例8 に降じてシクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を表-5に示す。

表 - 6

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化平 (%)	e −カプロラクタム 収 単 (%)	ィーカプロラクタム 選択 率(%)
1.8	1,00	8 1.1	8 1.1
2. 3	100	8 5.5	8 6.5
8.8	9 9. 6	8 5: 5	8 6.9
4. 8	9 9.2	8 6.0	8 6.7
5.8	9 8.7	8 5.7	8 6.9
6. 8	9 8.0	8 8.8	8 5.6
7. 8	9 7. 1	8 5.3	8 7. 9

触媒孤製例 B

(8-1) li・2SM-5 の合成

触媒制製例2-1に於けるエタノール容媒をエチレングリコール容媒に代える他は、触媒調製例2-1に単じて水熱合成を行ない、その後同様に後処理を行なって、H 2SM-5

数 一 6

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率 (%)	€ 一カプロラクタム 収 率 (%)	εーカプロラクタム 型 が 平 (%)
1. 8	9 9. 1	8 5.8	8 6. 6
2. 8	9 3.0	8 7. 7	8 9. 5
8.8	9 7. 5	8 7. 9	9 0.2
. 4.8	9 7. 0	8 8.8	9 1.1
6.8	9, 6. 9	8 8.0	9 0.9
6.8	9 6.8	8 8.2	9 1.6
7. 3	9 5.6	8 6.4	9.0.5

参考例8

触媒調製例 8 - 1 で得た H-2SM-6 を触媒に用いる他は実施例 8 に限じてシクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を設一7に示す。

炎 - 7

紅過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化率 (%)	εーカプロラクタム 収 略 (%)	ェーカプロラクタム 選 択 率 (%)
1.8	9 9.5	8 0.8	8 0.7
2, 8	9 7. 5	7 9.9	8 1.9
8.8	9 4.1	7 6.9	8 1.7
4.8	8 9.8	7 3.9	8 2.3
5.8	8 6.2	7 0.0	8 1.8
6.8	8 2.5	6 7. 2	8 1.4

触媒躢製例 4

(4-1) H·ZSM-5の合成

以下の組成から成る原料板をまず調製する。

 A 液
 B 液
 C液

 蒸留水
 1629 蒸留水
 119.79 蒸留水 281.79

 H2 SO4
 16.79 3号ナイ酸ソーダ 18639 NaCl 70.99

 Al2(SO4)*17HzO 0.169

 (n-Pr) (NBr 20.39

上記C板に、A板、B板を同時に商店を協っての時系内のpHを9~11に保存がら激したの時系内のpHを9~11に保存があるとした。この時系内のpHはのため、48%NaUH水約69を添加した)。 混合終を1 ℓの SU S製オートクレーブに仕込み、160 Cで20 hrs、400 r.p.m以上の回転数で提拌しながら、水熱合成を行なった。 冷却ではしながらい、水熱合成を行なった。 冷却ではした 大量になる でんした。 の段階のはくなる で、十分 たみ した。 の段階の間にしたところ、細孔外面積

(4 - 2) TMUS による表面処理

触媒調製例 4 - 1 で得た H・Z SM-5 を用い、 触媒調製例 1 - 2 に準じて TMCS による表面 処理を行なった。 処理された H・Z SM-5 の表 面酸強度は pKa=-3.0 であった。

実施例 5 (高い WHSV 条件でのテスト)

触媒調製例 4 - 2 で得た表面処理 H. 2SM-5を触媒に用い、実施例 3 に準じてシクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。 得られた結果を炭ー 8 に示す。

装 - 8

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	€ーカブロラクタム 収 邓 (%)	εーカプロラクタム 遊 択 率 (%)
1.8	9 7. 6	8 4.6	8 6.6
2. 3	9 4.3	8 8 4	8 8.4
3.3	9 1.3	8 3.2	9 1.1
4.3	9 0.8	8 2.6	9 1 0
5.8	8 9. 9	8 2.0	9 1.2
6.8	8 9.8	8 1.4	9 0.6

として 18.8 m/8 なる直を得た。次いでこの 乾燥された結晶を $500\sim550$ で 4 hrs 空気流 通下焼成し、白色粉末状結晶を 48 % 得た。 このものの X 線回折測定の結果、 2SM-5 と 同定された。

参考例 4

触媒調製例4-1で調製した24~48メッシュ粒径のH-2SM-5を触媒に用い、実施例 8に単じてシクロヘキサノンオキシムの転位 反応を行なった。得られた結果を表-9に示す。

表 - 9

能過時間 (brs)	シクロヘキサノンオ キシム駅化率(%)	cーカプロラクタム 収 準 (%)	
1.8	100	7 6.8	7 6.8
2. 3	9 9.8	8 1.0	8 1.6
3.8	9 8.3	7 9.6	8 1.0
4.3	9 6.9	8 2.2	8 4.8
5.8	9 5.4	8 1.0	8 5.0
6. 3	9 3.6	7 9. 7	8 5.1

比較例1~3(高いWHSV条件でのテスト)

Si/Al 原子比が 7.9~49.2 なる H. 2SM-5 を各々触媒に用いる以外は実施例 3 と同様な条件下で反応を行なった。

羽られた結果を数-10~12に示す。

表-10 Si/Al=7.9のH: ZSM-5 触媒

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	εーカプロラクタム 収 率 <i>(%</i>)	εーカプロラクタム 遇択 率 (%)
1. 8	6 0.0	2 6.8	4 3.8
2. 3	8 7. 8	1 4.5	8 8.9
8.8	3 0.5	1 0. 1	3 8.1

表-11 Si/Al=17.3のH: ZSM-5触媒

経過時間 (hrs)	シクロヘキザノンオ キシム転化率 (%)	εーカプロラクタム 収 率 (%)	εーカプロラクタム 選択 率 (%)
1.8	6 6.0	2 4.4	8 7.0
2. 8	2 5.8	1 0.1	3 9.1
8.8	8.9	4.1	4 6.0

表-12 Si/Al=49.2のH:ZSM-5触媒

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	ε ーカプロラクタム 収 率 (%)	
1.8	6 8.5	3 4.8	5 0.1
2. 8	2 4.1	1 3.2	5 8.4
3.8	1 4.3	7. 7	5 3.8

比較例 4

Si/Al 原子比 = 4 9. 2 の H $\cdot ZSM-5$ を触媒に用い、 8 wt% シグロヘキサノンオキシム/ベンゼン溶板を <math>WHSV=1 0.8 hr^{-1} とする他は契施例 1 と同様に反応を行った。 得られた結果を表ー 1 8 kr r r r r

表 - 18

経過時間(hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	ε ーカブロラクタム 収 率 (%)	εーカブロラクタム 選択率(%)
1.8	-8 0. 5	4 2.7	5 8.0
2. 8	7 5.0	48.6	5 8.2
8.8	6 8.7	4 2.0	6 1.1
4.8	6 2. 5	4 0.0	6 4.0
5.8	5 5.2	8 6.2	6 5.5
6. 9	4.7.8	8 1. I	6 5.7

比較例 5

シリカアルミナ (触媒化成体製、アルミナ合有率= 2 6 %) 触媒を 0.6 % 似い、 7.5 3 wt%のシクロヘキサンオキシム/ベンゼン格 被を WHSV=9.77 hr⁻¹とする他は尖維例 1 と同

はな条件で反応を行なった。 得られた結果を数一14に示す。

... 表 一...14

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	ℓーカブロラククム 収 率 (%)	ェーカプロラクタム 選択率(%)
2	1 0 0	5 6.1	5 6.1
8	100	5 8 9	5 8.9
4	100	5 7. 5	5 7. 5
Б	100	6 8.9	5 8.9
6	. 100	6 1.0	6 1.0
7	100	6 1.6	6 1.6
8	100	6 1.8	6 1.8
9	1 0 0	6 4.2	6 4.2
1 0	100	6 1.6	6 1. 6
1.1	100	6 5.1	6 5. 1
1 2	100	6 4.8	6 4.8

比較例 6

8 0 wt% B2U2/ZnU 触媒を 0.6 9 使う他は 比較例 5 と同様な条件で反応を行なった。 得られた結果を安一 1 5 に示す。・

我 一 15

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化率 (%)	ェーカプロラクタム 収 率 (%)	マーカプロラクタム 選択 平 (%)
2	100	9 8.0	9 8.0
8	9 7. 5	9 2.8	9 5.2
4	9 5.1	. 8 5.9	9 0.8
Б .	9 2.0	8 1.4	8 8.5
6	8 8.4	7 6.9	8 7. 0
7	8 1.7	6 7. 5	8 2. 6
8	7 4.8	5 9.0	7 9.4
9	6 5.9	4 9.6	7 5.8
10	5 4. l	8 9 2	7 2 5
11	4 7.6	· 8 1.4	6 6.0
12	8 6.2	2 0.8	5 9.8

2SM-5 を触媒に用い、実施例 8 に準じてシ クロヘキサノンオキシムの転位反応を行なっ

た。得られた結果を表ー18に示す。

表- 16 MerSiCl2 処理H·ZSM-5 触媒による反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	ℓーカプロラクタム 収 率 (%)	ェーカプロラクタム 選 択 率 (%)
1. 3	9 7. 5	8 7. 2	8 9.4
2. 8	9 4.9	8 8.6	9 8.4
8.8	9 1.6	8 6.2	9 4.1
4.8	9 1. 2	8 5.7	9 4.0
5. 3	8 8.8	8 8.2	9 8.7
6.8	8 7. 5	8 1.8	9 8.5

数- 17 MesGeCℓ処型H·2SM-5 触媒による反応結果

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化準(%)	€ーカプロラクタム 収 準 (%)	セーカプロラクタム 遊 択 率 (%)
1.8	9 8.9	9 0.8	9 1.8
2. 3	9 8.0	8 9.9	9 1.7
8.8	9 6.1	8 8.5	9 2.1
4.8	9 6.0	8 9.7	9 3 4
5.8	9 5.5	8 8.5	9 2.7
6.8	9 4. 4	8 6.5	9 1.6

触媒調製例 5

触媒調製例 $\Gamma - 1$ に準じ Si/Al 原子比= 6、4 0 0 の H 2SM-5 を合成した。 このものの表面酸強度は指示薬法で測定して、Ho=-8 であった。又、 8 5 0 C での 4 M Q Q 発量 = 0. 8 μ eq \sqrt{s} 、細孔外表面積 = 2 9. 2 m/s であった。

上記で得られた 2 4 ~ 4 8 メッシュの H 2 SM-5 を 0.5 9 使用し、触媒調製例 1 - 2 に準じ、ジクロロジメチルシラン又はクロロトリメチルゲルマニウムを 1.1 8 mmol/hr、N2 ガスを 1 ℓ/nr、流しながら 8 5 0 Cで 5 時間表面処理を行なった。

実施例 6 及び 7 (高い WHSV 条件でのテスト) 触媒調製例 5 で得られた設面処理 H・2 SM-5 を触媒に用い、実施例 8 に準じてシクロヘ キサノンオキシムの転位反応を行なった。 得られた結果を表 - 1 6 及び 1 7 に示す。 参考例 5

触媒調製例 5 の前段で得られた未処理のH·

表 - 18 未処型 H・2 SM - 6 触媒による反応結果

経過時間 (hrs).	シクロヘキサノンオ ギジム転化率(%)	ェーカプロラクタム 収 率 (%)	モーカプロラクタム 週 択 率 (%)
1.3	100	8 8.8	8 8.8
2.8	100	8 5.8	8 5.8
8.8	9 9.7	8 5 4	8 5.7
4.8	9 9.4	8 6. 5	8 7. 1
5.8	9 9. 1	8 5.8	8 6.1
6. 8	9 8.6	8 6.1	8 7.8

触媒調製例 6

(6-1) ボロシリケート・ゼオライトの合成
1.5 ℓのステンレス製オートクレーブに、
10%の水酸化テトラー n ープロピルアンモニウム水溶液 2 1 7.5 ℓ、エタノール 2 1 4 ℓ、ホウ酸 1 4.8 mを含む水溶液 2 mℓ、高純度のテトラエチルオルソシリケート (Aℓ<10 ppm以下) 1 0 0 ℓ をこの混合液の pH ⇒ 1 2.5 であった。オートクレーブのフタを閉め、内温を105 ℃に保ち、400 r.p.m以上の回

転で提拌を行ないながら、48時間水熱合成 を行なった。オートクレープの圧力は約2、5 ねんに達した。

水熱合成終了後、触媒調製例1の後半部に 準じて、沪過、洗浄、乾燥を行ない、との段 階でBET表面積を測定したところ、細孔外 装面積として 1 5.0 m/8 の値を得た。この乾 燥された結晶を更に 500~550 Cで 4 時 間空気々流下焼成し、29.09の粉末状白色 結晶を得た。このものの粉末X線回折の結果、 25M-6と類似構造を有するポロ・シリケー トと闘定された原子吸光法による元素分析の 結果、Si/B 原子比= 3,020であった。触 媒調製例1−1に雄じ、NH4Cℓイオン交換、 洗浄、焼成を経て日型ボロ・シリケートを得 た。尚とのものの袋面酸強度は指示薬法で Ho=-3.0 を示し、又4MQの吸着量から計 算された細孔外般量は1.0 8 μ当量/ 8 であ

(6-2)表面処理

上記で得られたポロシリケートを 0.5 9 用 い、触媒調製例1-2に準じ、TMCSを1.18 mmol/hr, N2 ガス1 l/hr.流しながら、850 でで 5 時間波面処理を行なった。

実施例を(高いWHSV 条件でのテスト)

触媒調製例 6 - 2 で得られた TMCS 処理・ ポロシリケートを触媒に用い、実施例3に準 じて、シクロヘキサノンオキシムの転位反応 を行なった。得られた結果を設一19に示す。

表 - 19

経過時間 (hrs)			
	キシム転化率 (%)	仅率(%)	遊 択 率 (%)
1.8	100	9 0.8	9 0.8
2. 8	9 9. 5	9 0.9	9 1.4
3. 8	9 9. 2	9 1.4	9 2.1
4.8	9 8.6	9 0.8	9 2.2
5.8	9 7. 9	9 0.3	9 1.0
6. 8	9 7. 5	8 8 8	9 0.6

参考例 6

触媒調製例 6 - 1 で得られた H型のポロシ クロヘキサノンオキシムの転位反応を行なっ た。得られた結果を表ー20に示す。

要 - 20

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	eーカプロラクタム 収 率 (%)	・ ーカプロラクタム ・
1.8	100	7 4.8	7 4.8
2. 3	9 9.7	8 4.9	8 5.2
8.8	9 9.8	8 5.7	8 6.8
4.8	9 8.8	8 1.3	8 2. 3
5.8	9 7. 9	8 8.0	8 4.8
6.8	9 7. 0	8 2.9	8 5.5

実 施 例 9 (高 い WHSV 条件でのテスト)

触媒調製例でで得られた Me 2 Si (OMe) 2 処理 リケートを触媒に用い、実施例 8 に準してシー・ポロシリケートを触媒に用い、実施例 8 に準 じて、シクロヘキサノンオキシムの転位反応 を行なった。得られた結果を表一21に示す。

表 - 21

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム 転化率 (%)		εーカプロラクタム 選択率(%)
1.8	9 5.6	8 5.0	8 8.9
2. 8	9 1.8	8 4.5	9 2. 5
8.8	8 8.0	8 1.0	9 2.1
4.8	8 4.1	7 9.8	9 4. 9
5.8	8 2.2	7 6.8	9 2.8
6.8	8 0.1	7 2.2	9 0. 1

触媒調製例 7

触媒調製例 6-1で得られたポロシリケー トを 0.5 9 用い、触媒調製例 1 - 2 に準じ、 ジメトキシジメチルシランを 1.1 8 mmol/hr, Nº ガスを 1 ℓ/hr. 流しながら、 3 5 0 ℃で 5 時間要面処理を行なった。

触媒調製例 8

触媒調製例 6 - 1 に草じ、Si/Ga 原子比= 1,986なる H型ガロシリケートを合成した。 このものの指示薬法で測った酸強度は Ho=+80、 細孔外表面積は1 6.9 m/8、細孔外酸量は4.5 μeq/9 であった。 C C で得られた H 型のガロ

シリケートを 0.5 g 用い、触媒調製例 1 - 2 に準じ、 TMCS を 1.1 g mmol/hr, N2ガスを 1 g/hr. 流しながら、 3 5 0 ℃で 5 時間表面 処理を行なった。

実施例 1 0 (高い WHSV 条件でのテスト)

触媒類製例 8 で得た TMCS 処理ガロシリケートを触媒に用い、実施例 8 に準じて、シクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を表ー2 2 に示す。

容考例 8

触媒調製例 8 の前段で得られた未処理の H 型ガロシリケートを触媒に用い、実施例 8 に単じて、シクロヘキサノンオキシムの転位反応を行なった。得られた結果を表一2 3 に示す。

麦 - 22

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率(%)	マーカプロラクタム 収 率 (%)	ェーカプロラクタム 週 択 率 (%)
1.8	9 8.7	8 9. 2	9 0.4
2. 8	9 6.1	8 7.8	9 0.8
8. 3	9 4.1	8 3.9	8 9.2
4. 8	9 1.7	8 2. 2	8 9.7
5.8	8 9.5	8 0.7	9 0.2
6. 8	8 7.4	7 9. 5	9 1.0

表 - 28

経過時間 (hrs)	シクロヘキサノンオ キシム転化率 (%)	€ーカプロラクタム 収 率 (%)	εーカプロラクタム 選 択 率 (%)
1. 3	9 9.7	8 1.6	8 1.9
2. 8	9 9.2	8 1.4	8 2.1
8.8	9 8.4	8 2. 1	8 8.5
4.8	9 7.4	8 2.5	8 4.7
5. 3	9 5.9	8 4.2	8 7. 8
6. 8	9 5.0	7 9.9	8 4.2

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

平3.2.26発行 昭和 62 年特許願第 17748 号 (特開昭 62-281856 号,昭和 62 年 12 月 7 日 発行 公開特許公報 62-2819 号掲載)につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 3 (2)

Int. C1. \$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1546 774	
B01J 29/28 Z-6750-4G	nt. C1.	識別記号	<u></u>
	B011 29/28		Z-6750-4G

5. 補正の対象

明細書の「特許請求の範囲」及び「発明の詳

細な説明」の各間

- 6. 補正の内容
 - (I) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
 - (2) 明細書第33頁第1行の「直」を「値」と補正する。

以 上

手成 3. 2.26 発行

平成2年10月25日

中成 2 年 1 U 月 ZS

適

特許庁長官 段

1. 事件の表示

昭和62年特許願第17748号

2. 発明の名称

ε ーカプロラクタムの製造法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願入

住 所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 (平成元年2月13日住居表示変更)

名 称 (209) 住友化学工業株式会社

代表者

英雄

4. 代理人

住 所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号

住友化学工業株式会社内

名 弁理士(8597)諸 石 光 TEL(06)220-3404



等許. 2.10.29

特許請求の範囲

(I) シクロヘキサノンオキシムを気相下に制御指数 1~12の結晶性ゼオライト系触媒と接触せしめて ε ーカプロラクタムを製造するに当り、触媒として一般式 (I)

 $R_{4-n}MX_n$ (1)

(式中、Rは同一もしくは異なる炭素数1~6のアルキル基又はフェニル基を示し、MはSi 又はGe、XはCl又は炭素数1~6のアルコキシ基を示し、nは1又は2を示す。)

で表わされる有機金属化合物で表面処理した結晶性セオライト系触媒を使用することを特徴とする ε ーカブロラクタムの製造法。

(2) 結晶性ゼオライト系触媒がアルミノシリケート・ゼオライトであり、そのSi/A ℓ 原子比が500以上である特許請求の範囲第1項記載の εーカブロラクタムの製造法。

(3) 結晶性ゼオライト系触媒がメタロシリケート ・ゼオライトであり、そのSi/メタル原子比が、 500以上である特許請求の範囲第1項記載の c ーカプロラクタムの製造法。

(4) 結晶性ゼオライ上系触媒の細孔外表面積が 5 m²/g以上である特許請求の範囲第 1 ~ 3 項記載の c ーカブロラクタムの製造法。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.